

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T _a = 25°C)					電 気 的 特 性 (T _a = 25°C)											外 形	備 考			
				V _{CBO} (V)	V _{EBO} (V)	I _C (mA)	P _C (mW)	T _j (°C)	I _{CBO} 最大値		直流又はパルス h _{FE}		バイアス		h _{je} h _{jb} *	h _{ie} h _{ib} * (Ω)	h _{re} h _{rb} * (×10 ⁻⁴)	h _{oc} h _{ob} * (μU)	f _{ab} f _T * (Mc)			C _{ob} (pF)	r _{bb'} h _{ip} (real)* (Ω)	
									(μA)	V _{CB} (V)	V _{CE} (V)	I _C (mA)	V _{CB} (V)	I _E (mA)										
2SC1271	日電	RF	Si.E	20	3	30	250	200	0.05	8	100	8	10	8	-10				6000*	C _{re} 0.4		190		
# 1272	"	"	"	20	3	100	1W	200	50 nA	15	80	10	40	10	-40	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)			4000*	C _{re} < 2		190		
# 1273	"	"	"	20	3	100	1W (T _c = 25°C)	175	50 nA	15	80	10	40	10	-60	G _{pe} = 4dB (f = 4GHz)						190		
# 1274	"	SW	"	40	5	300	300	175	0.25	20	70	1	30	8	-10	t _{on} < 80 nS, t _{off} < 66 nS t _{sig} < 65 nS			350*	2.5		49C		
# 1275	"	RF	"	30	3	50	250	200	0.1	15	80	10	10	10	-10	G _p = 15dB NF = 3dB (f = 500MHz) (f = 500MHz, 3mA)			2000*	1.1		50C		
# 1276	"	RF. SW	"	40	5	100	200	125	0.1	30	120	1	10	10	-10	t _{on} < 20 nS, t _{off} < 40 nS t _{sig} < 20 nS			600*	3	60*	138		
# 1277	"	RF	"	60	5	500	250	125	0.5	30	140	2	100	10	-20				60*	20	30*	138		
# 1278	"	RF. SW	"	150	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10				150*	4.5	15	138		
# 1279	"	"	"	180	5	50	250	125	0.1	100	120	3	15	10	-10				150*	4.5	15	138		
# 1280	"	RF	ゲーリントン Si.E	15	10	300	250	125	0.1	10	20,000	5	100	10	-10				180*	5	220*	138		
# 1281	沖	"	Si.P	20	5	20	300	175	0.1	15	200	1	10 μA	5	-1				120*	2	60*	49C		
# 1282	"	"	"	70	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1				120*	2	60*	49C		
# 1283	"	"	"	110	5	20	300	175	0.1	15	73	1	2	5	-1				120*	2	60*	49C		
★ # 1284	三洋	Osc	Si.EP	30	3	50	200	125	0.1	20	25~200	6	1	6	-1				700*	C _{re} 0.92				
★ # 1285	"	RF. AF	Si	40	5	100	200	125	1	35	200	6	1	6	-1	180	2000	0.8	12	140*	3	C _e r _{bb'} 200 pS	138	
# 1286																								
# 1287																								
# 1288	沖	RF. SW	Si.EP	7	3	60	200	175	0.5	6	50	1	20	4	-20	t _d < 600 pS, t _f < 650 pS t _r < 650 pS			4500*	1	50*	144		
# 1289																								
# 1290	沖	PA	Si.EP	40	3	200	750	175	0.5	20	70	10	100	10	-50				*	2	35*	84B		
# 1291																								
★ # 1292	三菱	PA. SW	Si.EMe	300	5	2.5A	80W (T _c = 25°C)	150	200	300	25	10	500	t _r < 1.5 μS, t _f < 3 μS, t _{sig} < 2 μS								102		
# 1293	三洋	RF	Si.EP	25	3	50	300	125	1	20	15~120	6	1	6	-1				400*	C _{re} 1.3	C _e r _{bb'} 25 pS	138		
# 1294																								
# 1295	三洋	PA	Si.TMe	1000	7	2A	40W (T _c = 25°C)	150	100	100	3~13	5	1A	t _f < 1.3 μS								102		
★ # 1296	"	SW	Si.T	1300	6	5A	50W (T _c = 25°C)	150	100	100	> 4	5	3.5A										102	
# 1297	日電	PA	Si.E	50	4	3.5A	50W (T _c = 25°C)	175	1mA	30	50	10	2A	10	-700	P _o = 26W (f = 175 MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)			190*	75		149		
# 1298	"	"	"	50	4	5A	80W (T _c = 25°C)	175	2mA	30	50	10	3A	10	-1A	P _o = 37W (f = 175 MHz, V _{cc} = 18V, P _i = 10W)			130*	110		149		
# 1299	富士通	SW	Si.TMe	300	5	30A	200W (T _c = 25°C)	175	50	150	40	5	10A	5	-2A	t _{on} < 2.5 μS, t _f < 2.5 μS t _{sig} < 4 μS			25*			191		
# 1300	"	"	"	500	5	30A	200W (T _c = 25°C)	175	50	150	25	5	15A	5	-2A	t _{on} < 4 μS, t _f < 2.5 μS t _{sig} < 4 μS			20*			191		